# Контрольная работа № 2

## Вариант 27

### Задача №1

Нарисовать схему одиночного усилительного каскада на БТ с ОЭ и эмиттерной стабилизацией и выполнить расчет элементов схемы, задающих рабочую точку.

Выполнить графоаналитический расчет усилительного каскада в режиме класса "А". При расчетах использовать выходные статические характеристики транзистора.

## Исходные данные:

Тип транзистора: КТ3127А

$$U_{K0} = 6(B)$$

$$I_{K0} = 8(MA)$$

### Решение

Расчет элементов схемы одиночного усилительного каскада на БТ с ОЭ и эмиттерной стабилизацией, принципиальная схема которого приведена на рис 2.1, выполняется в следующей последовательности.

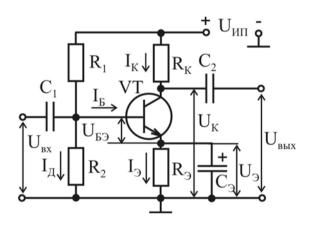


Рис 2.1

В рассматриваемом каскаде БТ работает в режиме "А", и положение рабочей точки задается примерно на середине нагрузочной прямой. Поэтому напряжение источника питания определяется из условия  $U_{\mathit{И\Pi}} = 2U_{\mathit{K0}} = 2 \cdot 6 = 12(\mathit{B})$ , а напряжение на резисторе  $R_{\mathit{K}}$  определяется выражением

$$U_{_{R_{_{K}}}}=U_{_{H\!\Pi}}-U_{_{K0}}=U_{_{K0}}=6(B)$$

Падение напряжение на резисторе  $R_{9}$  рекомендуется выбирать из диапазона значений  $U_{9} = (0.05...0.1)U_{\mathit{UII}}$  .

$$U_{\scriptscriptstyle 9} = 0.07 \cdot U_{\scriptscriptstyle HII} = 0.07 \cdot 12 = 0.84(B)$$

Вычисляем сопротивление резисторов:

$$R_{9} = \frac{U_{9}}{I_{9}} \approx \frac{U_{R_{9}}}{I_{K0}} = \frac{0.84}{8 \cdot 10^{-3}} = 105(O_{M})$$

$$R_K = \frac{U_{R_K}}{I_{K0}} = \frac{6}{8 \cdot 10^{-3}} = 750(O_M)$$

Напряжение  $U_{{\it E}{\it 9}}\,$  для кремниевых транзисторов лежит в диапазоне 0,6...0,8 В

Принимаем  $U_{B9} = 0.7(B)$ .

Напряжение на базе определяется как

$$U_B = U_{B9} + U_{9} = 0.7 + 0.84 = 1.54(B)$$

С учетом связи между токами транзистора  $\beta = \frac{I_K}{I_K} = 15$ , найдем ток базы:

$$I_E = \frac{I_K}{\beta} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{15} = 0.53 (MA)$$

Для обеспечения хорошей стабилизации рабочей точки ток делителя в цепи базы должен быть больше тока базы  $I_{\pi}=(5...10)I_{\kappa}$  .

Принимаем 
$$I_{\mathcal{A}} = 10 \cdot I_{\mathcal{B}} = 10 \cdot 0.53 \cdot 10^{-3} = 5.3 (\text{мA})$$

Сопротивления резисторов делителя находим согласно выражениям:

$$R_2 = \frac{U_B}{I_A} = \frac{1.54}{5.3 \cdot 10^{-3}} = 291(O_M)$$

$$R_1 = \frac{U_{M\Pi} - U_B}{I_A + I_E} = \frac{12 - 1.54}{5.3 \cdot 10^{-3} + 0.53 \cdot 10^{-3}} = 1.79(\kappa O_M)$$

Графоаналитический расчет усилителя проводим в следующем порядке. По справочнику определяем его максимально допустимые параметры:

- постоянный ток коллектора  $I_{K \max} = 20 (MA)$ ;
- постоянное напряжение коллектор-эмиттер  $U_{K \ni \max} = -20(B)$ ;
- постоянная рассеиваемая мощность коллектора  $P_{K \max} = I_K U_{K3} = 100 (MBT)$ .

На семействе выходных характеристик транзистора, как показано на рис 2.2, строим область допустимых режимов, ограниченную  $I_{K\max}, U_{K \ni \max}, P_{K\max}$ .

Выполняем построение нагрузочной прямой, которая описывается уравнением  $I_{\it K} = (U_{\it H\Pi} - U_{\it K3})/R_{\it K}$  . Прямая проводится через две точки , лежащие на осях координат:

- точку с координатами  $I_{\scriptscriptstyle K}=0, U_{\scriptscriptstyle K\!\!\!/\!\!\!/}=U_{\scriptscriptstyle M\!\!\!/\!\!\!/}=12(B)$  на оси напряжений;
- точку с координатами  $I_{\scriptscriptstyle K} = \frac{U_{\scriptscriptstyle M\!\Pi}}{R_{\scriptscriptstyle K}} = \frac{12}{750} = 16 ({\scriptscriptstyle M}A), U_{\scriptscriptstyle K\!9} = 0.$

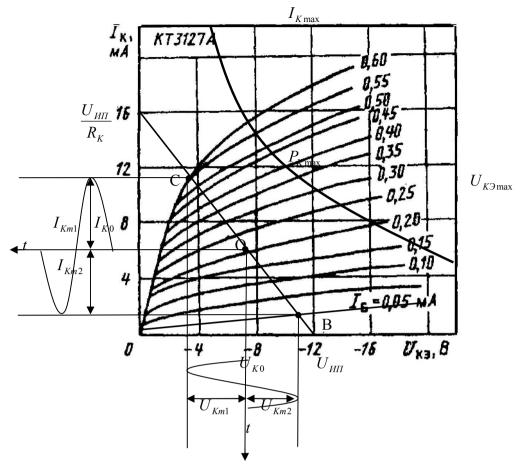


Рис 2.2

Максимальные значения амплитуды полуволн неискаженного сигнала соответствуют пересечению нагрузочной прямой с статическими характеристиками в точке "С" – режим насыщения и в точке "В" – режим отсечки.

Рабочая точка "О" находится на середине нагрузочной прямой, тогда

$$U_{Km} = \frac{U_{Km1} + U_{Km2}}{2} = \frac{11 - 3}{2} = 4(B);$$

$$I_{Km} = \frac{I_{Km1} + I_{Km2}}{2} = \frac{11 - 1.5}{2} = 4.75(MA).$$

Максимальная мощность неискаженного сигнала определяется выражением:

$$P_{Km} = \frac{1}{2}U_{Km}I_{Km} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4.75 \cdot 10^{-3} = 9.5(MBm)$$

Мощность, потребляемая от источника питания:

$$P_0 = U_{K0}I_{K0} = 7 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 42(MBm)$$

Тогда коэффициент полезного действия:

$$\eta = \frac{P_{Km}}{P_0} = \frac{9.5 \cdot 10^{-3}}{42 \cdot 10^{-3}} = 0.226$$

### Задача №2

Нарисовать схему электронного ключа на БТ с ОЭ и построить его передаточную характеристику  $U_{\rm \tiny \it Gold} = f(U_{\rm \tiny \it GX})$ . Если сопротивление нагрузки  $R_{\rm \it H} = 5R_{\rm \it K}$ . Тип транзистора, напряжение питания сопротивление резистора в цепи коллектора использовать в соответствии с исходными данными и решением задачи №1. Сопротивление резистора в цепи базы принять равным входному сопротивлению БТ  $R_{\rm \it E} = h_{\rm 119}$  рассчитанному для рабочей точки.

### Исходные данные:

Тип транзистора: КТ3127А

$$U_{K0} = 6(B)$$

$$I_{K0} = 8(MA)$$

## Решение

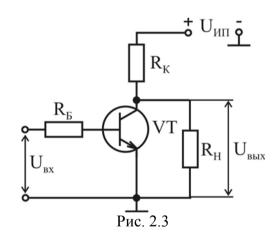
Передаточная характеристика  $U_{\rm \scriptscriptstyle GblX} = f(U_{\rm \scriptscriptstyle GX})$  электронного ключа на БТ, принципиальная схема которого представлена на рис 2.3, выполняется в следующей последовательности.

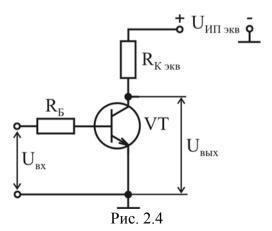
Находим параметры эквивалентной схемы ключа, показанной на рис. 2.4:

$$R_H = 5R_K = 5 \cdot 750 = 3.75 (\kappa O_M)$$

$$U_{H\Pi_{5K6}} = U_{H\Pi} \frac{R_H}{R_K + R_H} = 12 \cdot \frac{3750}{7550 + 3750} = 10(B);$$

$$R_{K_{3KG}} = \frac{R_K R_H}{R_K + R_H} = \frac{750 \cdot 3750}{750 + 3750} = 625(O_M)$$





На семействе выходных характеристик БТ  $I_K = f(U_{K\Im})\big|_{I_E=const}$  проводим нагрузочную прямую (рис. 2.5), описываемую уравнением  $I_K = \frac{U_{U\Pi\Im\kappa\sigma} - U_{K\Im}}{R_{K\Im\kappa\sigma}}$ , через две точки, лежащие на осях координат:

- точку с координатами  $I_K = 0, U_{K\mathfrak{I}} = U_{HII_{2KB}} = 10(B)$  на оси напряжений;

- точку с координатами 
$$I_{\scriptscriptstyle K} = \frac{U_{{\scriptscriptstyle M\Pi} {\scriptscriptstyle 9K6}}}{R_{{\scriptscriptstyle K} {\scriptscriptstyle 9K6}}} = \frac{10}{625} = 16 ({\scriptscriptstyle MA}), U_{{\scriptscriptstyle K} {\scriptscriptstyle 9}} = 0$$
 на оси токов.

Находим точки пересечения нагрузочной прямой с кривыми  $I_K = f(U_{K3})\big|_{I_E=const}$ , которые определяют токи базы  $I_{Ei}$  и выходные напряжения ключа  $U_{\text{вых}i} = U_{K3i}$  (i=1,...,N), где N- количество таких точек.

Входная ВАХ БТ  $I_{\it E}=f(U_{\it E3})|_{U_{\it K3}=const}$ , соответствующая  $U_{\it K3}\neq 0$ , позволяет найти напряжения  $U_{\it E3i}$ , соответствующие выходным напряжениям  $U_{\it ebixi}$ , как показано на рисунке 2.6. В качестве напряжения  $U_{\it E3i}$ , соответствующего  $I_{\it E}=0$ , используют пороговое напряжение  $U_{\it E3nop}$ , которое определяется напряжением точки пересечения прямой, аппроксимирующей входную ВАХ при больших значениях тока базы, с осью абсцисс (рис 2.6). Тогда соответствующие входные напряжения вычисляются согласно выражению:

$$U_{exi} = U_{E\ni i} + I_{Ei} \cdot R_E$$
.  
 $R_E = h_{11\ni} = \frac{\Delta U_{E\ni}}{\Delta I_E} \bigg|_{U_{E\ni}=const} = \frac{0.8 - 0.65}{0.2 - 0} = 0.75(O_M)$ 

Получаем

$N_{\underline{0}}$	$I_{\scriptscriptstyle E}$ , м $A$	$U_{{\scriptscriptstyle E}\!\ni},B$	$U_{\scriptscriptstyle \it GMX}(U_{\scriptscriptstyle \it K\Im}), B$	$U_{ex}, B$
1	0	0.65	9	0.65
2	0.05	0.72	8.3	0.76
3	0.1	0.75	7.5	0.825
4	0.15	0.775	7	0.89
5	0.25	0.8	6.2	0.99
6	0.35	0.8	5	1.06
7	0.45	0.8	4.7	1.14
8	0.6	0.8	3	1.25

Полученные пары значений  $U_{\rm \tiny \it buxi}$  и  $U_{\rm \tiny \it buxi}$  позволяют построить передаточную характеристику ключа, представленную на рас. 2.7. Высокий выходной уровень  $U^1_{\rm \tiny \it bux}$  соответствует работе БТ в режиме отсечки (точка "1"):

$$\boldsymbol{U}_{\scriptscriptstyle{\mathit{BbIX}}}^1 = \boldsymbol{U}_{\scriptscriptstyle{\mathit{И}\Pi\mathfrak{I}\mathfrak{S}\mathit{K}\mathit{B}}} - \boldsymbol{I}_{\scriptscriptstyle{K}\mathfrak{I}\mathfrak{I}}\boldsymbol{R}_{\scriptscriptstyle{K}} \approx \boldsymbol{U}_{\scriptscriptstyle{\mathit{U}\Pi\mathfrak{I}\mathfrak{S}\mathit{K}\mathit{B}}}\,.$$

Низкий выходной уровень соответствует работе в режиме насыщения (точка "8"):  $U^0_{\scriptscriptstyle \it EMX} = U_{\scriptscriptstyle \it K\mbox{\it CP} nac}$  .

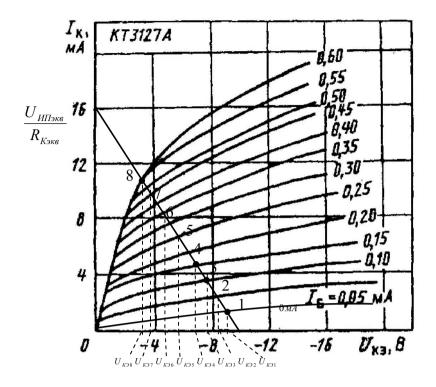


Рис. 2.5

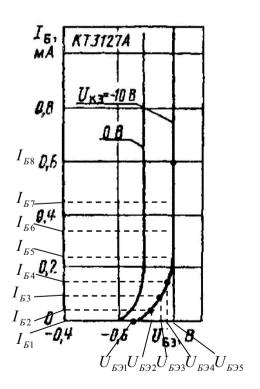


Рис. 2.6

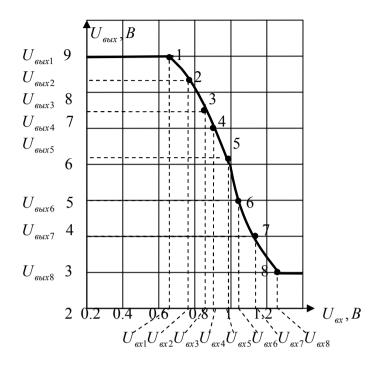


Рис. 2.7

Ha передаточной характеристике отсечки, ключа имеется три области: соответствующая уровням входного малым напряжения; активная область, соответствующая переключению БТ из режима отсечки в режим насыщения и наоборот; область насыщения, соответствующая большим уровням входного напряжения.

### Задача №3

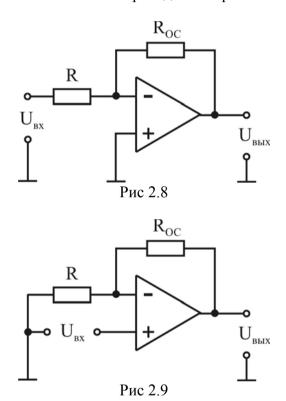
Изобразить принципиальные схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителя на основе ОУ и рассчитать для каждого усилителя коэффициент усиления  $K_{OC}$ , входное  $R_{sx,OC}$  и выходное  $R_{sux,OC}$  сопротивление.

## Исходные данные:

$$R = 10(\kappa O_M); R_{OC} = 20(\kappa O_M); K = 40000; R_{ex} = 600(\kappa O_M); R_{ebbx} = 0.4(\kappa O_M).$$

### Решение

Параметры инвертирующего и неинвертирующего усилителей практически полностью определяются элементами цепи обратной связи. Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей на основе ОУ приведены на рис. 2.8 и 2.9 соответственно.



Коэффициент усиления по напряжению усилителя, охваченного петлей отрицательной ОС, можно рассчитать по формуле:

$$K_{OC} = \frac{K}{1 + \beta \cdot K}$$

где K - собственный коэффициент усиления по напряжению ОУ;  $\beta$  - коэффициент передачи цепи ОС.

Для схемы инвертирующего усилителя (рис. 2.8), коэффициент передачи цепи равен

$$\beta = \frac{R}{R_{OC}} = \frac{10}{20} = 0.5$$

Получаем 
$$K_{OC} = \frac{K}{1 + \beta \cdot K} = \frac{40000}{1 + 0.5 \cdot 40000} = 2$$

В случае реального ОУ коэффициент усиления инвертирующего усилителя определяется выражением

$$K_{OC} = -rac{K_{s\phi}}{1+eta\cdot K_{s\phi}}$$
, где  $K_{s\phi} = rac{K\cdot R_{OC}}{R_{OC}+R}$ .

Получаем

$$K_{9\phi} = \frac{K \cdot R_{OC}}{R_{OC} + R} = \frac{40000 \cdot 20}{20 + 10} = 26670$$

$$K_{OC} = -\frac{K_{9\phi}}{1 + \beta \cdot K_{9\phi}} = -\frac{26670}{1 + 0.5 \cdot 26670} = 2$$

Знак "минус" отражает инвертирование входного сигнала.

В случае идеального ОУ  $K \to \infty$ , тогда

$$K_{OC} = -\frac{1}{\beta} = -\frac{R_{OC}}{R} = -\frac{20}{10} = -2$$

Для схемы неинвертирующего усилителя (рис. 2.9) коэффициент передачи цепи ОС

$$\beta = \frac{R}{R + R_{OC}} = \frac{10}{10 + 20} = 0.333$$

В случае реального ОУ коэффициент усиления неинвертирующего усилителя определяется выражением

$$K_{OC} = \frac{K}{1 + \beta \cdot K} = \frac{40000}{1 + 0.333 \cdot 40000} = 3.003$$

В случае идеального ОУ  $K \to \infty$ , тогда

$$K_{OC} = 1 + \frac{R_{OC}}{R} = 1 + \frac{20}{10} = 3$$

Дифференциальное входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется сопротивлением резистора на входе:

$$R_{ex,OC} = R_{ex} = 600(\kappa O_M)$$

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя определяется как входное сопротивления усилителя, охваченного последовательной отрицательной ОС:

$$R_{\text{ex.OC}} = R_{\text{ex}}(1 + \beta \cdot K) = 600 \cdot 10^3 \cdot (1 + 2 \cdot 40000) = 4.8 \cdot 10^{10} (O_M)$$

где  $R_{ex}$  - входное сопротивление ОУ без ОС.

Выходное сопротивление для обеих схем усилителей определяется как

$$R_{\text{\tiny GbIX.OC}} = \frac{R_{\text{\tiny GbIX}}}{1 + \beta \cdot K}$$

Для инвертирующего усилителя получаем:

$$R_{\text{\tiny GbIX.OC}} = \frac{R_{\text{\tiny GbIX}}}{1 + \beta \cdot K} = \frac{0.4 \cdot 10^3}{1 + 0.5 \cdot 40000} = 5 \cdot 10^{-2} (O_{\text{M}})$$

Для неинвертирующего усилителя:

$$R_{\text{\tiny BbIX.OC}} = \frac{R_{\text{\tiny BbIX}}}{1 + \beta \cdot K} = \frac{0.4 \cdot 10^3}{1 + 0.333 \cdot 40000} = 3.003 \cdot 10^{-2} (Om)$$